

Тиристор быстродействующий импульсный ТБИ243-500-22



Средний прямой ток	I_{TAV}	500 А
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	U_{DRM}	2000 - 2200 В
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}	
Время выключения	t_q	32.0, 40.0, 50.0, 63.0 мкс
$U_{DRM}, U_{RRM}, В$	2000	2200
Класс по напряжению	20	22
$T_j, ^\circ C$	- 60 ÷ 125	

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{TAV}	Средний ток в открытом состоянии	А	493 500 738	$T_c=85^\circ C$; двухстороннее охлаждение; $T_c=84^\circ C$; двухстороннее охлаждение; $T_c=55^\circ C$; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии	А	785	$T_c=84^\circ C$; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии	кА	10.0 11.5	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25^\circ C$	180 эл. град. синус; $t_p=10$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			10.5 12.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25^\circ C$	180 эл. град. синус; $t_p=8.3$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
I^2t	Защитный фактор	$A^2c \cdot 10^3$	500 660	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25^\circ C$	180 эл. град. синус; $t_p=10$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			450 590	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25^\circ C$	180 эл. град. синус; $t_p=8.3$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс

Блокирующие параметры				
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	2000 - 2200	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	2100 - 2300	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; единичный импульс; управление разомкнуто
U_D, U_R	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.6 \cdot U_{DRM}$ $0.6 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\max}$; управление разомкнуто
Параметры управления				
I_{FGM}	Максимальный прямой ток управления	А	8	$T_j = T_{j\max}$
U_{RGM}	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
P_G	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	8	$T_j = T_{j\max}$ для постоянного тока управления
Параметры переключения				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f=1$ Hz)	А/мкс	2000	$T_j = T_{j\max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; $I_{TM} = 2500$ А; Импульс управления: $I_G = 2$ А; $U_G = 20$ В; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt = 2$ А/мкс
Тепловые параметры				
T_{stg}	Температура хранения	°С	-60...+50	
T_j	Температура р-п перехода	°С	-60...+125	
Механические параметры				
F	Монтажное усилие	кН	14.0...16.0	
a	Ускорение	м/с ²	50	В зажатом состоянии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения
Характеристики в проводящем состоянии				
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	2.40	$T_j = 25$ °С; $I_{TM} = 1570$ А
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.569	$T_j = T_{j\max}$; $0.5 \cdot I_{TAV} < I_T < 1.5 \cdot I_{TAV}$
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	0.673	
I_H	Ток удержания, макс	мА	500	$T_j = 25$ °С; $U_D = 12$ В; управление разомкнуто
Блокирующие характеристики				
I_{DRM}, I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	100	$T_j = T_{j\max}$; $U_D = U_{DRM}$; $U_R = U_{RRM}$
$(du_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии ¹⁾ , мин	В/мкс	200, 320, 500, 1000, 1600, 2000, 2500	$T_j = T_{j\max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; управление разомкнуто

Характеристики управления					
U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	3.00 2.50 1.50	$T_j = T_{j\ min}$ $T_j = 25\ ^\circ C$ $T_j = T_{j\ max}$	U _D =12 В; I _D =3 А; Постоянный ток управления
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, макс	мА	500 300 150	$T_j = T_{j\ min}$ $T_j = 25\ ^\circ C$ $T_j = T_{j\ max}$	
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.35	$T_j = T_{j\ max}$; U _D =0.67·U _{DRM} ;	Постоянный ток управления
I_{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	мА	50.00		

Динамические характеристики					
t_{gd}	Время задержки включения, макс	мкс	0.75	$T_j = 25\ ^\circ C$; U _D =1000 В; I _{TM} =I _{TAV} ; di/dt=200 А/мкс;	
t_{gt}	Время включения ²⁾	мкс	1.60, 2.00, 2.50, 3.20	Импульс управления: I _G =I _{FGM} ; U _G =20 В; t _{GP} =50 мкс; di _G /dt=2 А/мкс	
t_q	Время выключения ³⁾ , макс	мкс	32.0, 40.0, 50.0, 63.0	du _D /dt=50 В/мкс;	$T_j = T_{j\ max}$; I _{TM} = I _{TAV} ; di _R /dt=-10 А/мкс; U _R =100 В; U _D =0.67U _{DRM}
			40.0, 50.0, 63.0, 80.0	du _D /dt=200 В/мкс;	
Q_{rr}	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	300	$T_j = T_{j\ max}$; I _{TM} = I _{TAV} ; di _R /dt=-50 А/мкс ; U _R =100 В	
t_{rr}	Время обратного восстановления, макс	мкс	5.0		
I_{rrM}	Ток обратного восстановления, макс	А	145		

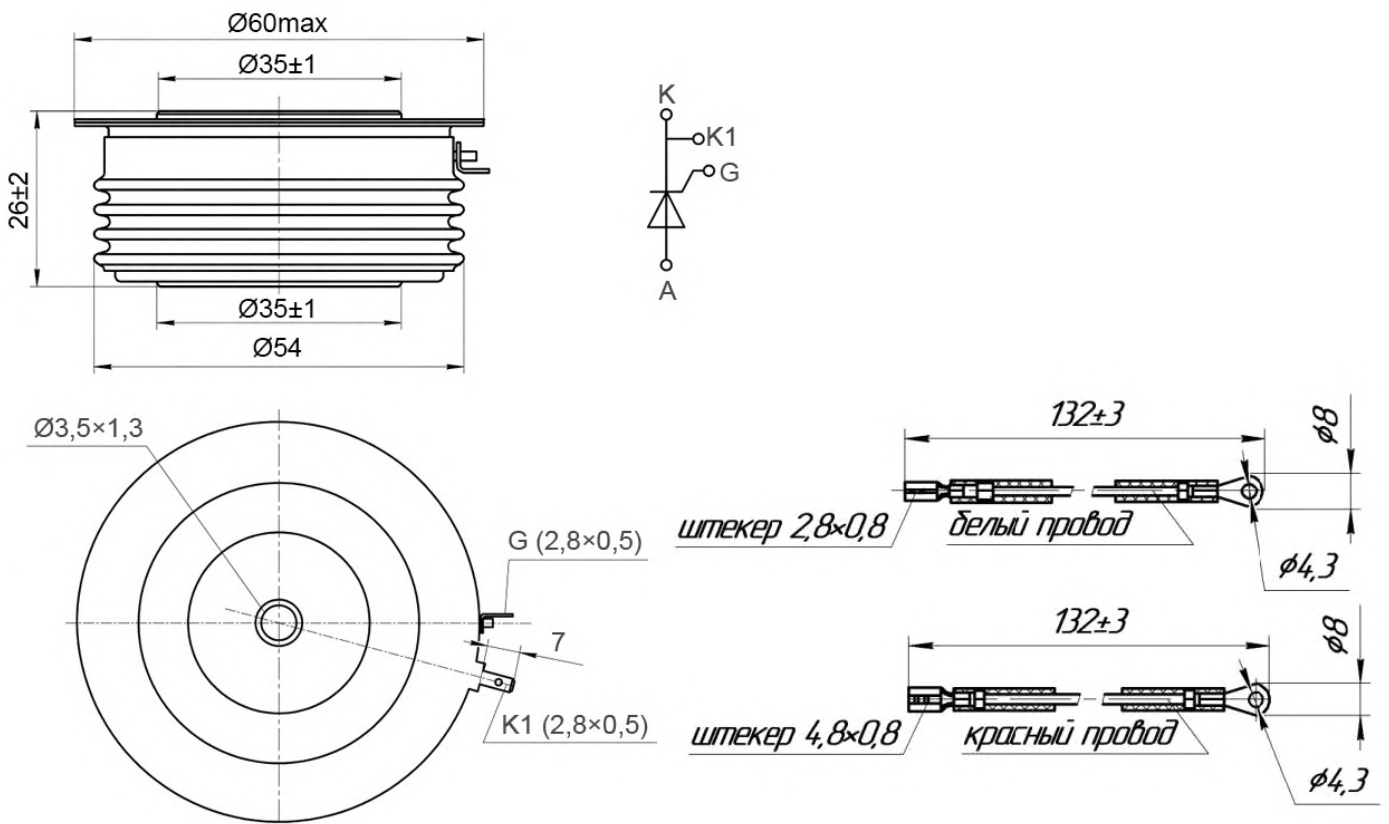
Тепловые характеристики					
R_{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	°C/Вт	0.0340	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R_{thjc-A}			0.0748		Охлаждение со стороны анода
R_{thjc-K}			0.0612		Охлаждение со стороны катода
R_{thck}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	°C/Вт	0.006	Постоянный ток	

Механические характеристики					
w	Масса, не более	г	280		
D_s	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	27.6 (1.087)		
D_a	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	16.0 (0.630)		

МАРКИРОВКА								ПРИМЕЧАНИЕ																																											
ТБИ	243	500	22	A2	K3	P4	УХЛ2	¹⁾ Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии <table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th> <th>P2</th> <th>K2</th> <th>E2</th> <th>A2</th> <th>T1</th> <th>P1</th> <th>M1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(dv_D/dt)_{crit}, В/мкс</td> <td>200</td> <td>320</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>1600</td> <td>2000</td> <td>2500</td> </tr> </tbody> </table> ²⁾ Время включения <table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th> <th>T4</th> <th>P4</th> <th>M4</th> <th>K4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>t_{gt}, мкс</td> <td>1.60</td> <td>2.00</td> <td>2.50</td> <td>3.20</td> </tr> </tbody> </table> ³⁾ Время выключения (du _D /dt=50 В/мкс) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th> <th>K3</th> <th>H3</th> <th>E3</th> <th>C3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>t_q, мкс</td> <td>32.0</td> <td>40.0</td> <td>50.0</td> <td>63.0</td> </tr> </tbody> </table>								Обозначение группы	P2	K2	E2	A2	T1	P1	M1	(dv _D /dt) _{crit} , В/мкс	200	320	500	1000	1600	2000	2500	Обозначение группы	T4	P4	M4	K4	t _{gt} , мкс	1.60	2.00	2.50	3.20	Обозначение группы	K3	H3	E3	C3	t _q , мкс	32.0	40.0	50.0	63.0
Обозначение группы	P2	K2	E2	A2	T1	P1	M1																																												
(dv _D /dt) _{crit} , В/мкс	200	320	500	1000	1600	2000	2500																																												
Обозначение группы	T4	P4	M4	K4																																															
t _{gt} , мкс	1.60	2.00	2.50	3.20																																															
Обозначение группы	K3	H3	E3	C3																																															
t _q , мкс	32.0	40.0	50.0	63.0																																															
1	2	3	4	5	6	7	8																																												
1. Тиристор быстродействующий импульсный 2. Конструктивное исполнение 3. Средний ток в открытом состоянии, А 4. Класс по напряжению 5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 6. Группа по времени выключения (du _D /dt=50 В/мкс) 7. Группа по времени включения 8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2																																																			

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: РТ43, Т.С3



- К – катод;
- А – анод;
- К1 – вспомогательный катод;
- Г – управляющий электрод;

Все размеры в миллиметрах

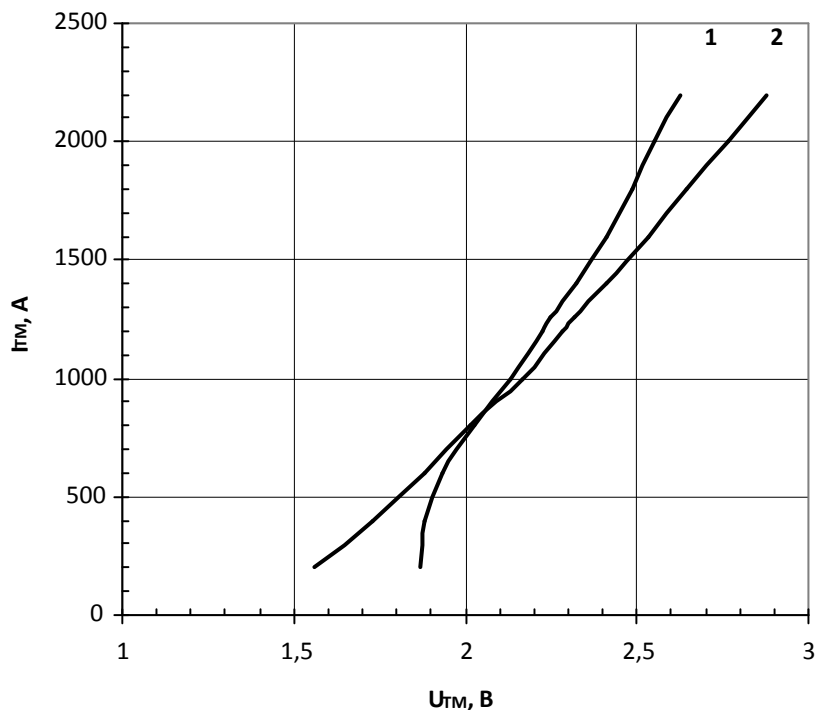
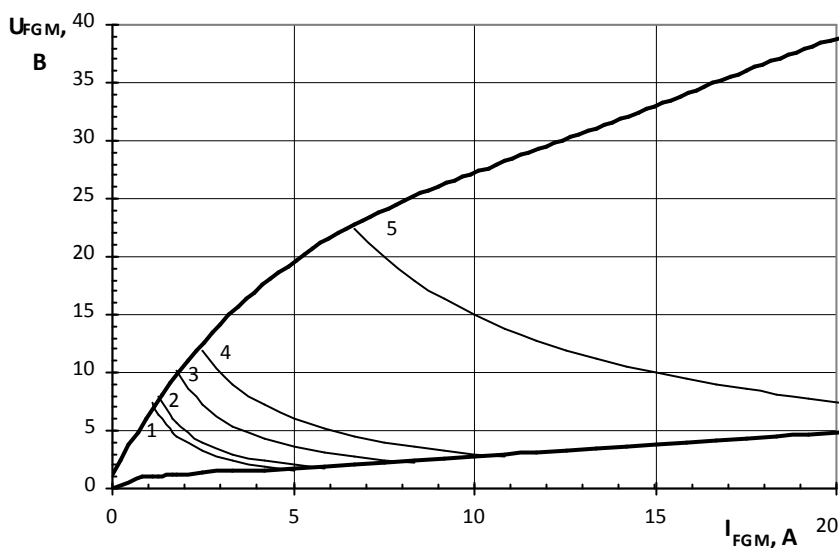


Рис.1 – Предельная вольт-амперная характеристика.
 1 – $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$ 2 –
 $T_j=125\text{ }^\circ\text{C}$



Максимальные потери мощности цепи управления

Позиция	Коэф. времени вкл.-выкл.	Длина импульса управл., мс	Энергия импульса цепи управл., Вт
1	1	DC	8
2	2	10	10
3	20	1	18
4	40	0.5	30
5	200	0.1	150

Рис.2 — Вольт-амперная характеристика цепи управления

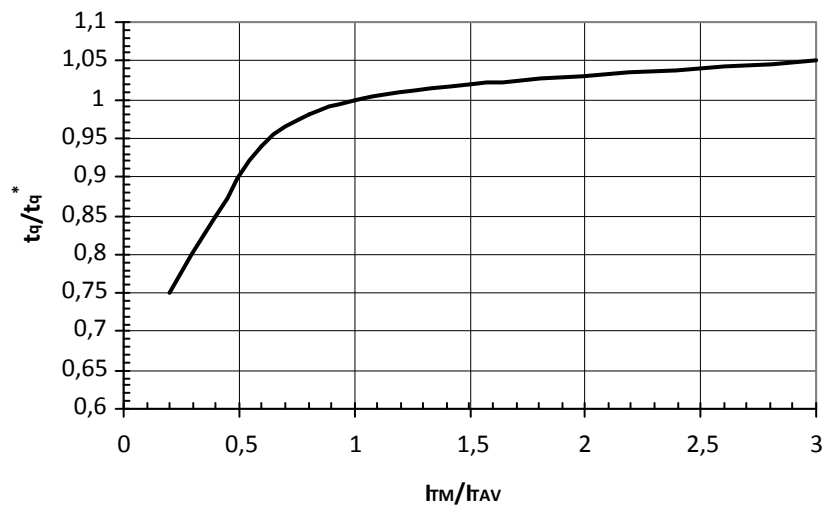


Рис. 3 — Зависимость времени выключения t_q от амплитуды тока в открытом состоянии I_{TM}

Условия: $T_j=T_{j\max}$; $di_R/dt=10$ А/мкс; $U_R=100$ В; $du_D/dt=50$ В/мкс; $U_D=0.67 \cdot U_{DRM}$

Типичное изменение t_q относительно нормированного t_q^* (t_q^* – см. информационный лист, $du_D/dt=50$ В/мкс)

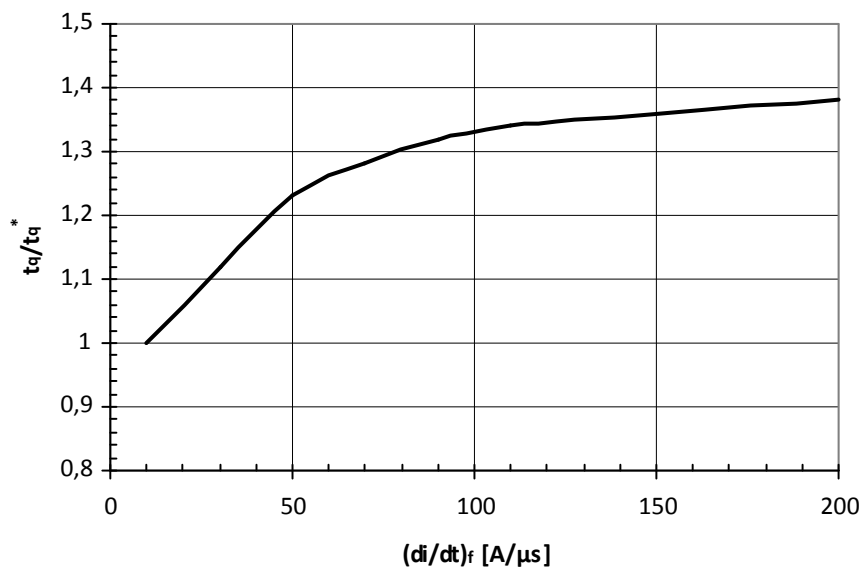


Рис. 4 — Зависимость времени выключения t_q от скорости спада анодного тока di_R/dt

Условия: $T_j=T_{j\max}$; $I_{TM}=I_{TAV}$; $U_R=100$ В; $du_D/dt=50$ В/мкс; $U_D=0.67 \cdot U_{DRM}$

Типичное изменение t_q относительно нормированного t_q^* (t_q^* – см. информационный лист, $du_D/dt=50$ В/мкс)

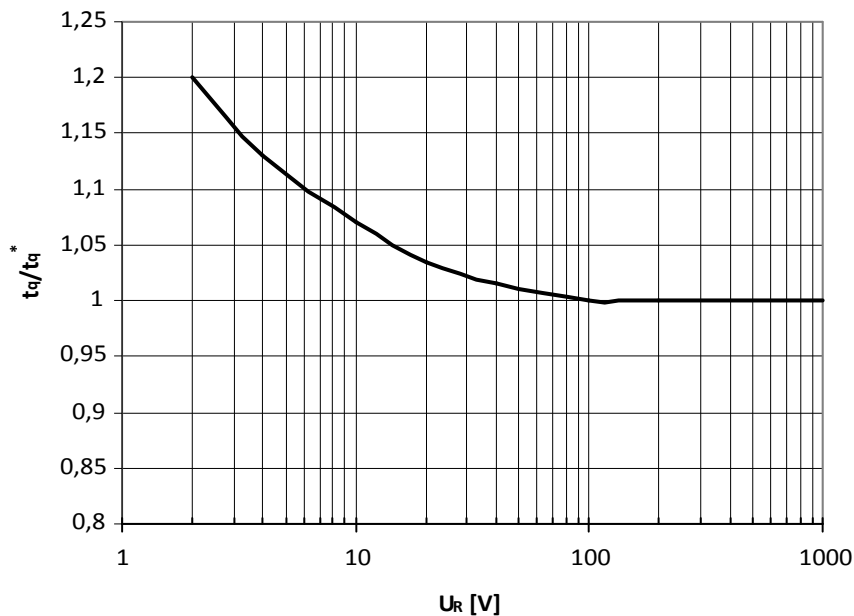


Рис. 5 — Зависимость времени выключения t_q от обратного напряжения U_R

Условия: $T_j=T_{j\max}$; $I_{TM}=I_{TAV}$; $di_R/dt=10$ А/мкс; $du_D/dt=50$ В/мкс; $U_D=0.67 \cdot U_{DRM}$

Типичное изменение t_q относительно нормированного t_q^* (t_q^* – см. информационный лист, $du_D/dt=50$ В/мкс)

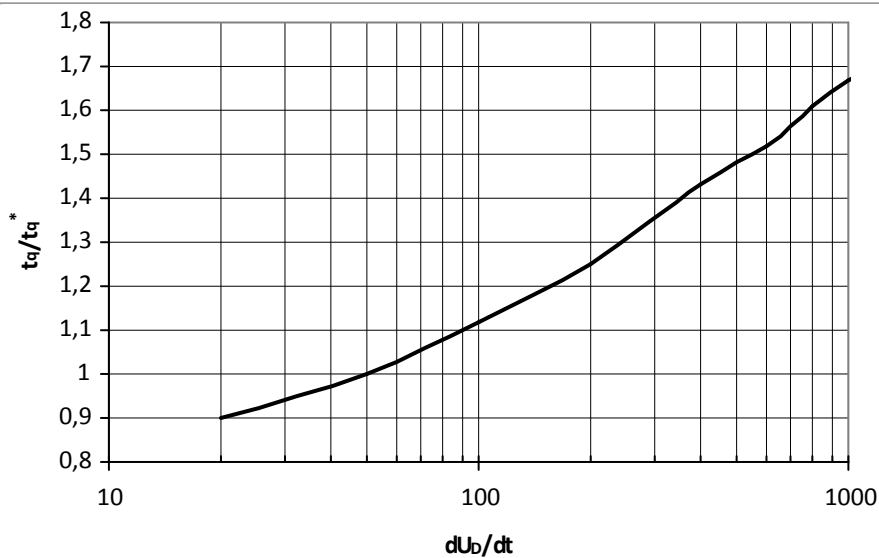


Рис. 6 — Зависимость времени выключения t_q от скорости нарастания напряжения du_0/dt

Условия: $T_j=T_{j\max}$; $I_{TM}=I_{TAV}$; $di_R/dt=10$ А/мкс; $U_R=100$ В; $U_D=0.67 \cdot U_{DRM}$

Типичное изменение t_q относительно нормированного t_q^* (t_q^* – см. информационный лист, $du_0/dt=50$ В/мкс)

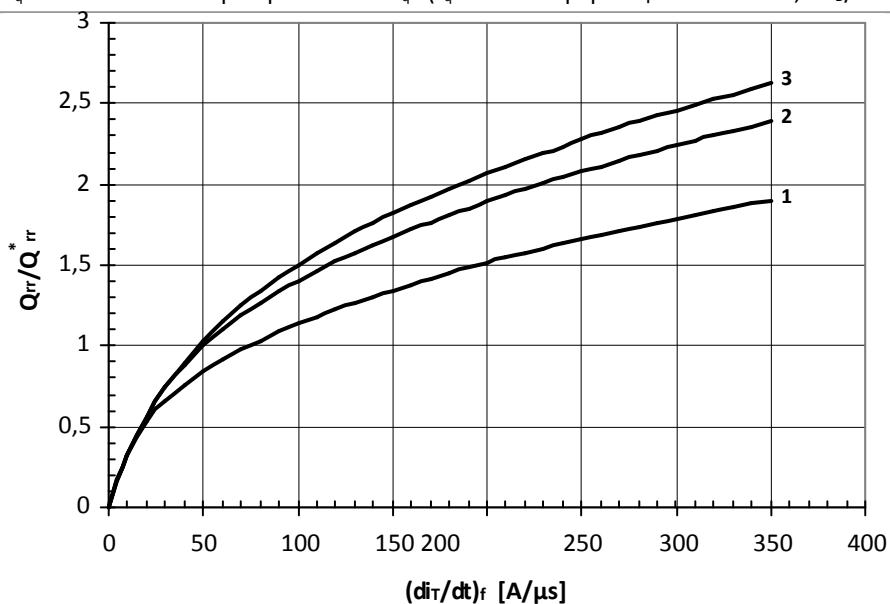


Рис. 7 — Зависимость заряда обратного восстановления Q_{rr} от скорости спада анодного тока di_R/dt

1 – $I_{TM} = 0.5 \cdot I_{TAV}$,

2 – $I_{TM} = I_{TAV}$,

3 – $I_{TM} = 1.5 \cdot I_{TAV}$

Условия: $T_j=T_{j\max}$; $U_R=100$ В

Типичное изменение Q_{rr} относительно нормированного Q_{rr}^* (Q_{rr}^* – см. информационный лист)

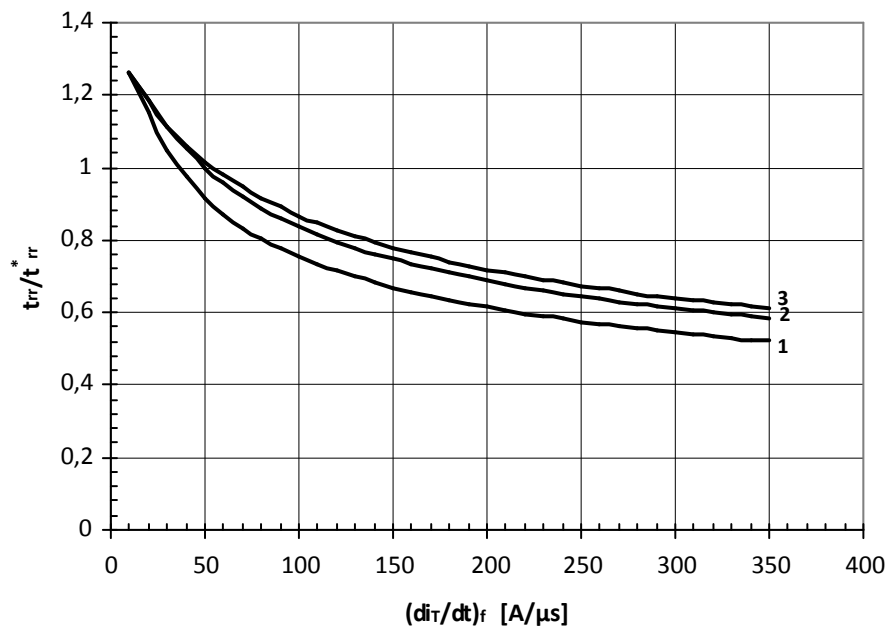


Рис. 8 — Зависимость времени обратного восстановления t_{rr} от скорости спада анодного тока di_R/dt

- 1 — $I_{TM} = 0.5 I_{TAV}$,
- 2 — $I_{TM} = I_{TAV}$,
- 3 — $I_{TM} = 1.5 I_{TAV}$

Условия: $T_j = T_{j \max}$; $U_R = 100$ В

Типичное изменение t_{rr} относительно нормированного t_{rr}^* (t_{rr}^* — см. информационный лист)

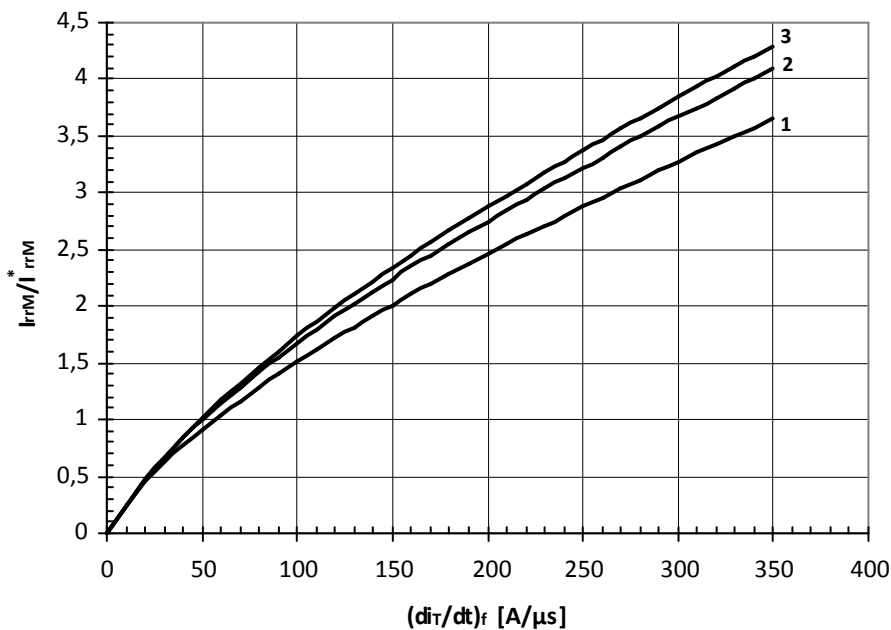


Рис. 9 — Максимальная зависимость тока обратного восстановления I_{rrM} от скорости спада анодного тока di_R/dt

- 1 — $I_{TM} = 0.5 I_{TAV}$,
- 2 — $I_{TM} = I_{TAV}$,
- 3 — $I_{TM} = 1.5 I_{TAV}$

Условия: $T_j = T_{j \max}$; $U_R = 100$ В

Типичное изменение I_{rrM} относительно нормированного I_{rrM}^* (I_{rrM}^* — см. информационный лист)

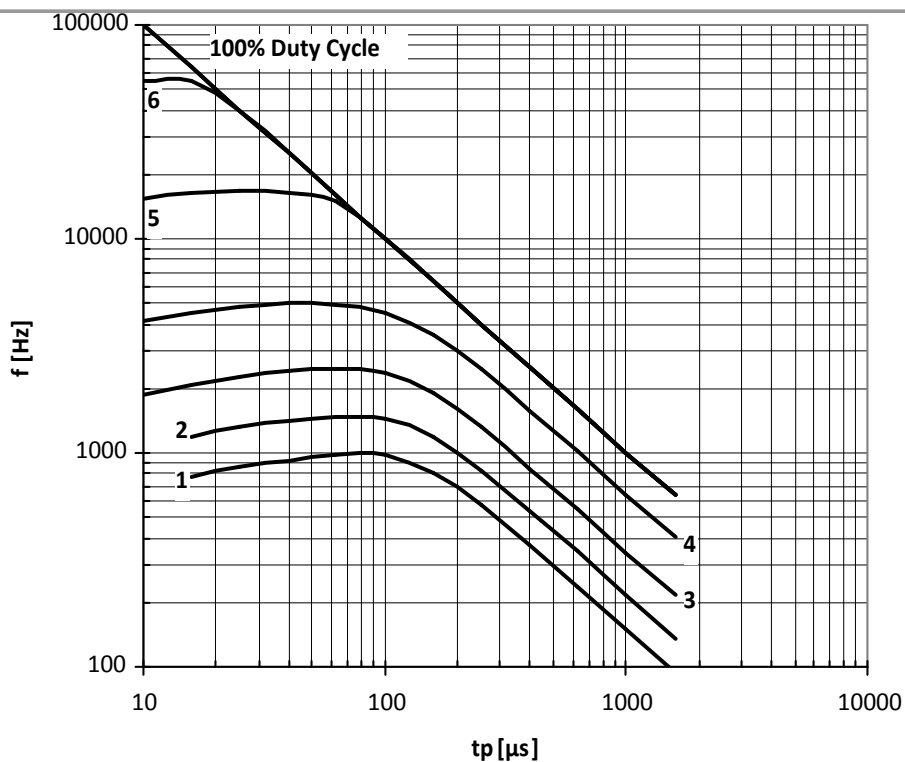


Рис. 10 — Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов тока

- 1 – $I_{TM} = 5000 \text{ A}$
- 2 – $I_{TM} = 4000 \text{ A}$
- 3 – $I_{TM} = 3000 \text{ A}$
- 4 – $I_{TM} = 2000 \text{ A}$
- 5 – $I_{TM} = 1000 \text{ A}$
- 6 – $I_{TM} = 500 \text{ A}$

Условия: $U_R \leq 3 \text{ В}$; $T_c = 55 \text{ }^\circ\text{C}$

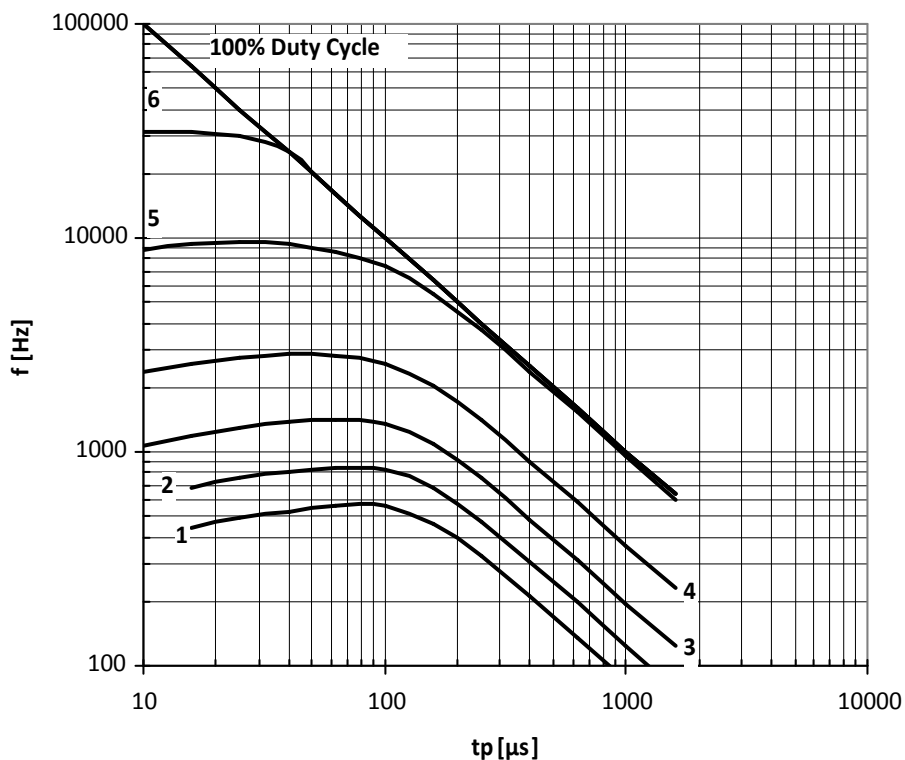


Рис. 11 — Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов тока

- 1 – $I_{TM} = 5000 \text{ A}$
- 2 – $I_{TM} = 4000 \text{ A}$
- 3 – $I_{TM} = 3000 \text{ A}$
- 4 – $I_{TM} = 2000 \text{ A}$
- 5 – $I_{TM} = 1000 \text{ A}$
- 6 – $I_{TM} = 500 \text{ A}$
- 7 – $I_{TM} = 250 \text{ A}$

Условия: $U_R \leq 3 \text{ В}$; $T_c = 85 \text{ }^\circ\text{C}$

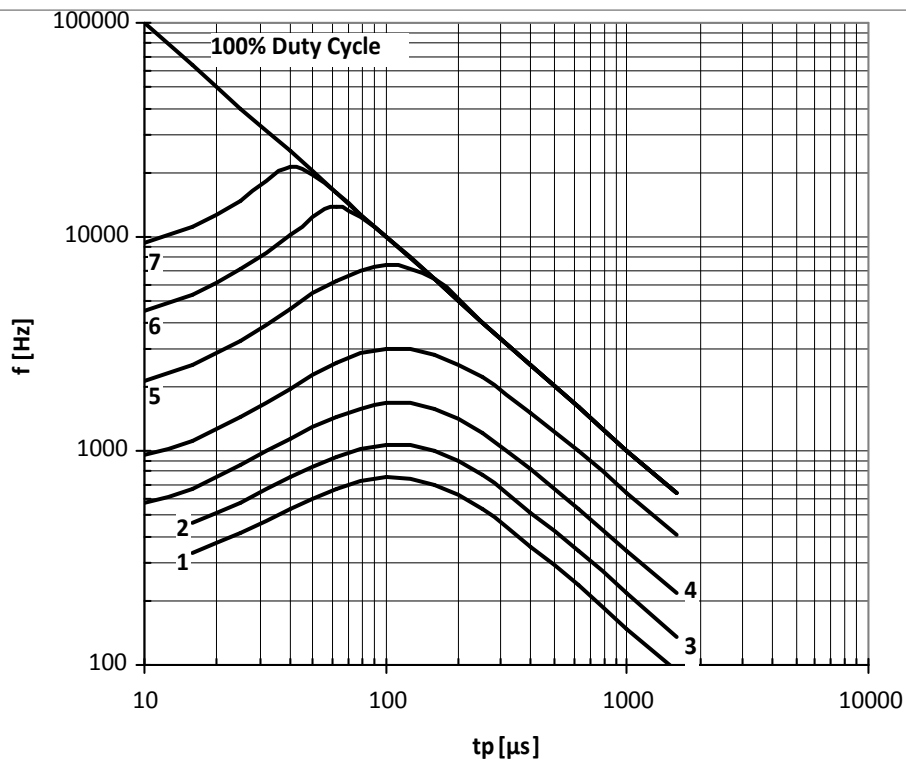


Рис. 12 — Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов тока

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$; $T_C = 55$ °C

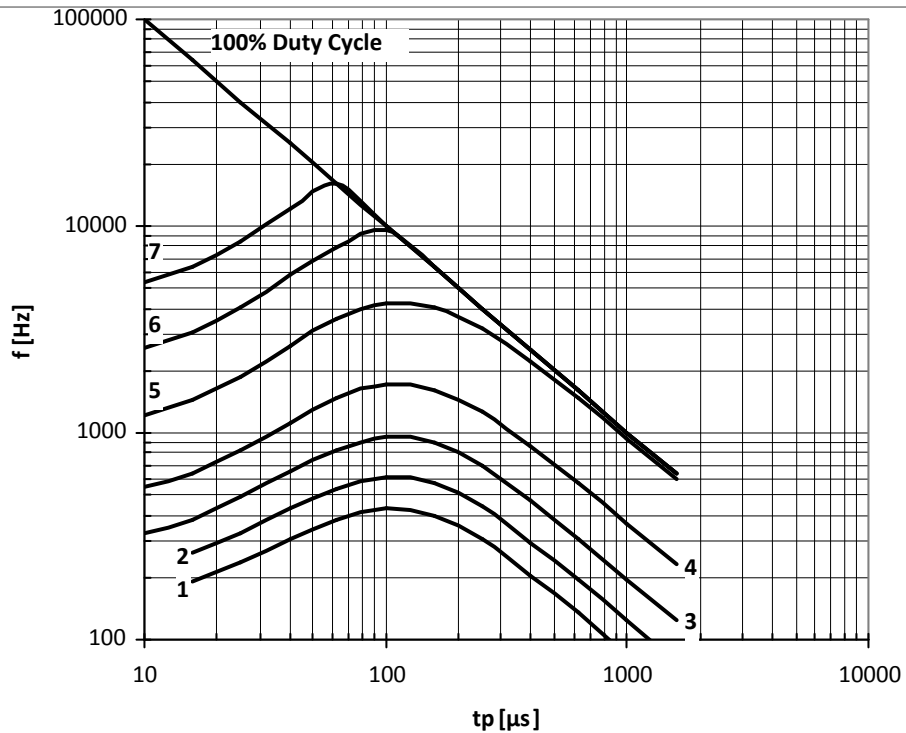


Рис. 13 — Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов тока

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$; $T_C = 85$ °C

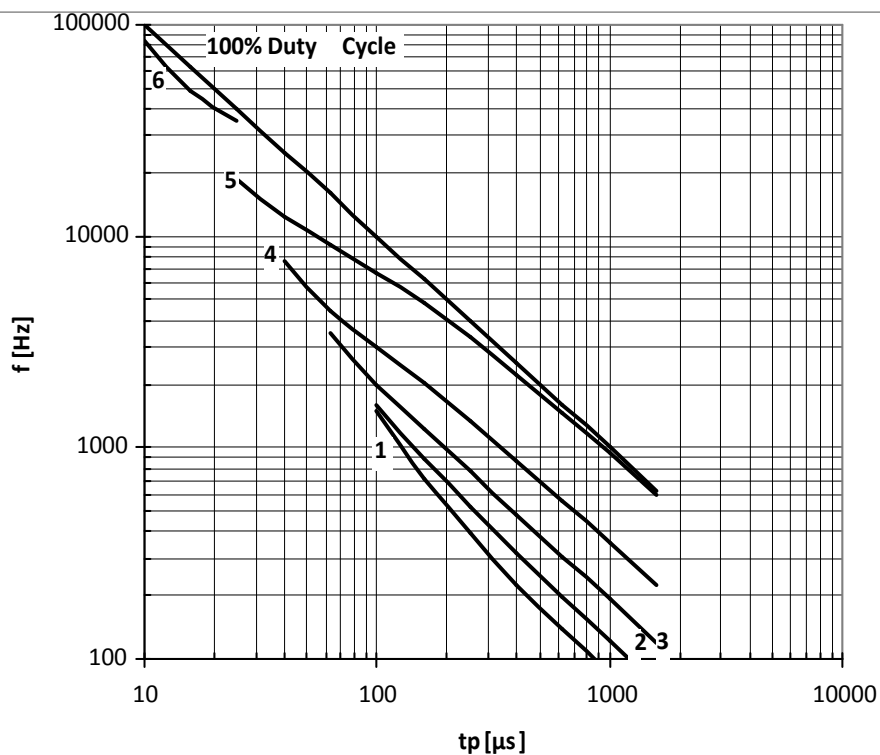


Рис. 14 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A

Условия: $U_R \leq 3$ В; $T_C = 55$ °С; $di_f/dt = di_R/dt = 100$ А/мкс

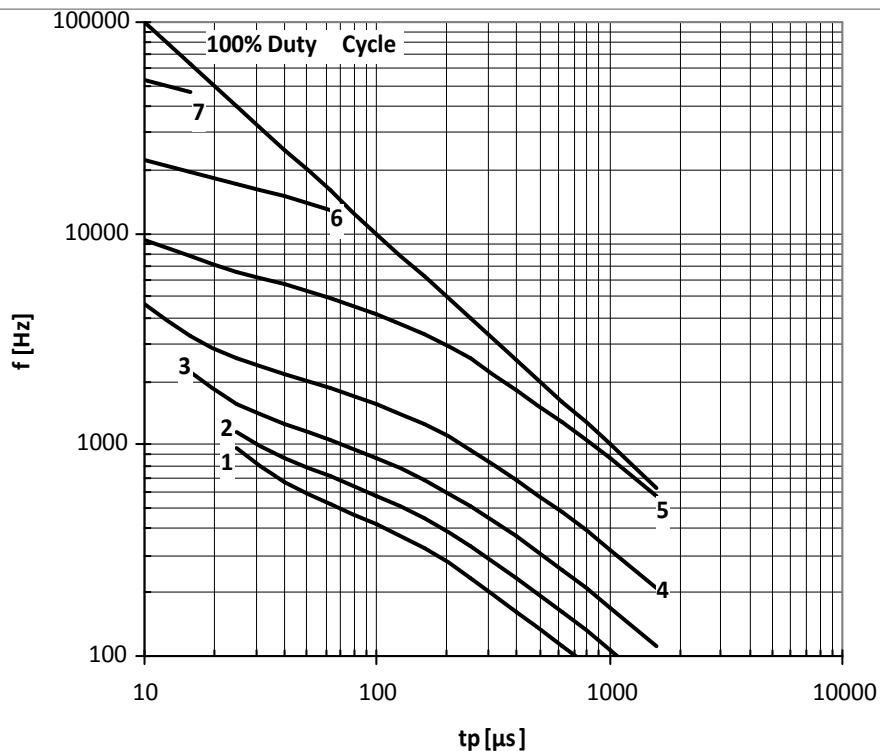


Рис. 15 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R \leq 3$ В; $T_C = 55$ °С; $di_f/dt = di_R/dt = 500$ А/мкс

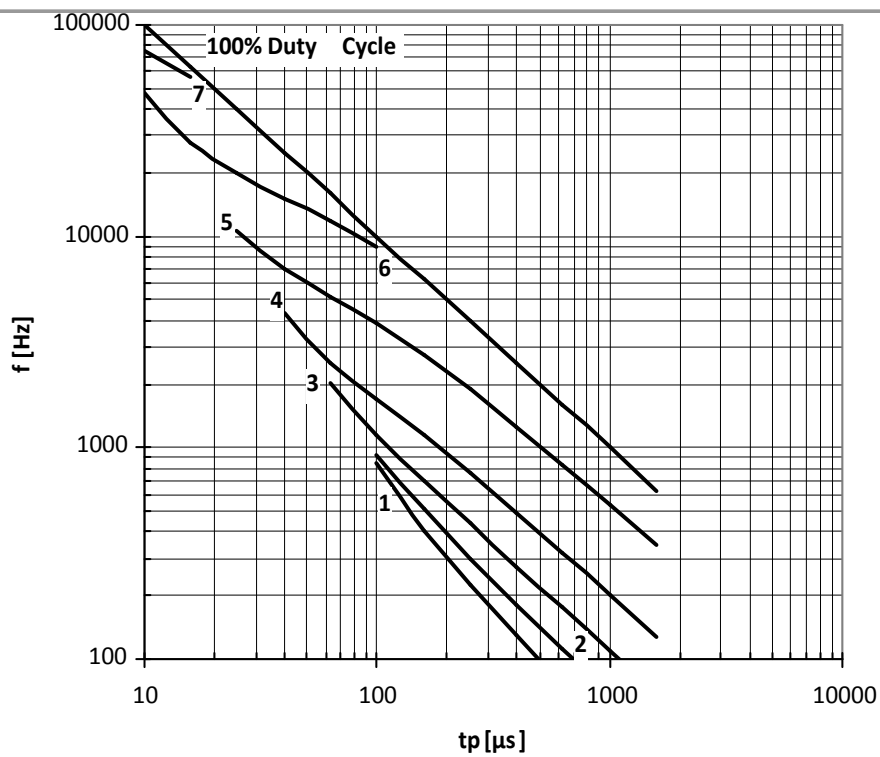


Рис. 16 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 — $I_{TM} = 5000$ A
- 2 — $I_{TM} = 4000$ A
- 3 — $I_{TM} = 3000$ A
- 4 — $I_{TM} = 2000$ A
- 5 — $I_{TM} = 1000$ A
- 6 — $I_{TM} = 500$ A
- 7 — $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R \leq 3$ В; $T_C = 85$ °С; $di_f/dt = di_R/dt = 100$ А/мкс

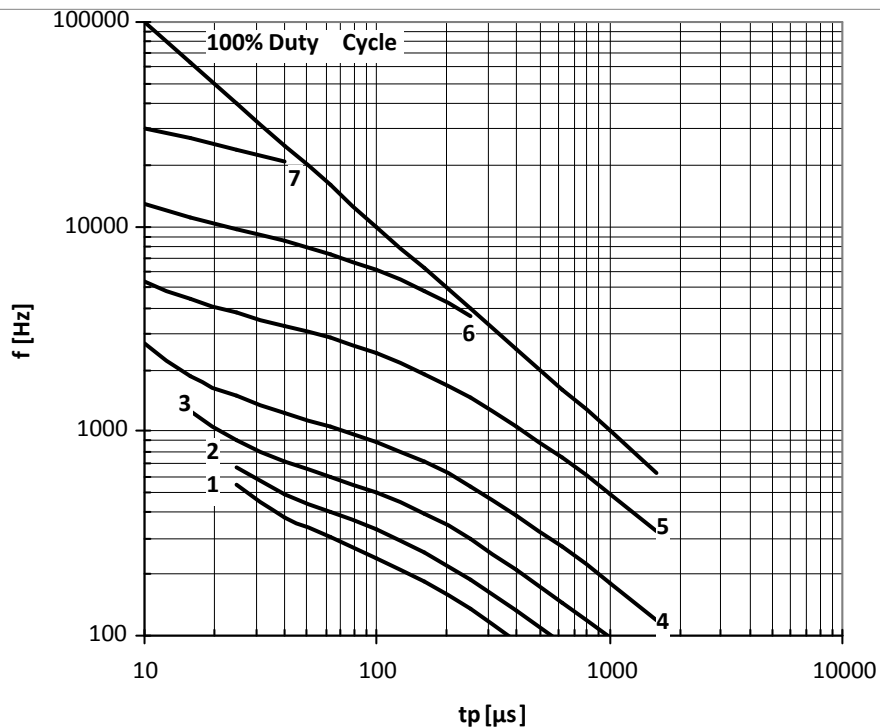


Рис. 17 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 — $I_{TM} = 5000$ A
- 2 — $I_{TM} = 4000$ A
- 3 — $I_{TM} = 3000$ A
- 4 — $I_{TM} = 2000$ A
- 5 — $I_{TM} = 1000$ A
- 6 — $I_{TM} = 500$ A
- 7 — $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R \leq 3$ В; $T_C = 85$ °С; $di_f/dt = di_R/dt = 500$ А/мкс

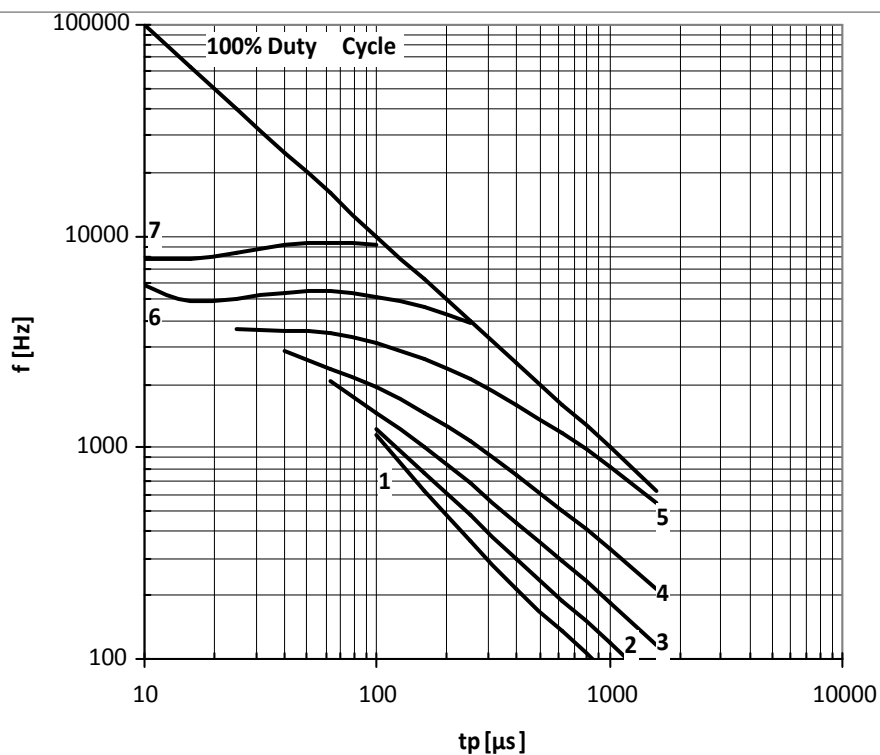


Рис. 18 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$; $T_c = 55$ °C; $di_f/dt = di_R/dt = 100$ A/мкс

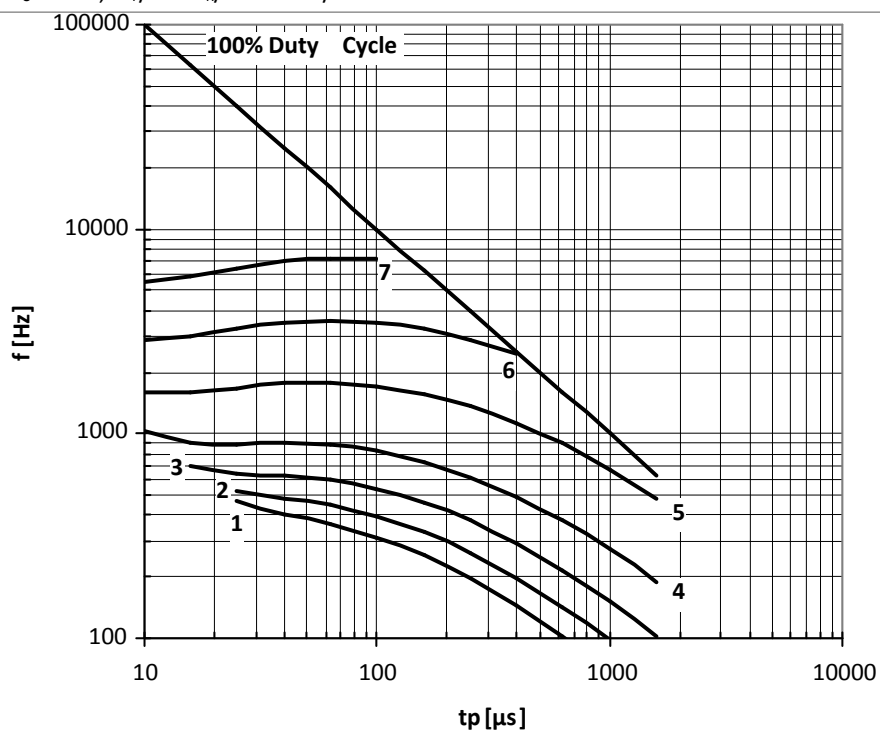


Рис. 19 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$; $T_c = 55$ °C; $di_f/dt = di_R/dt = 500$ A/мкс

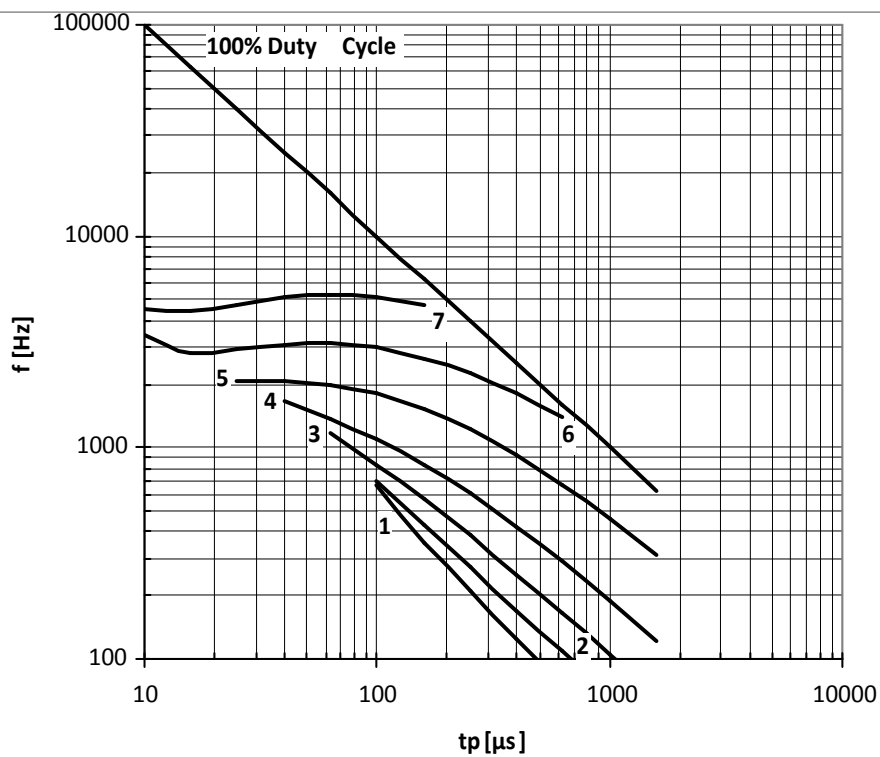


Рис. 20 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$; $T_C = 85$ °C; $di_F/dt = di_R/dt = 100$ A/мкс

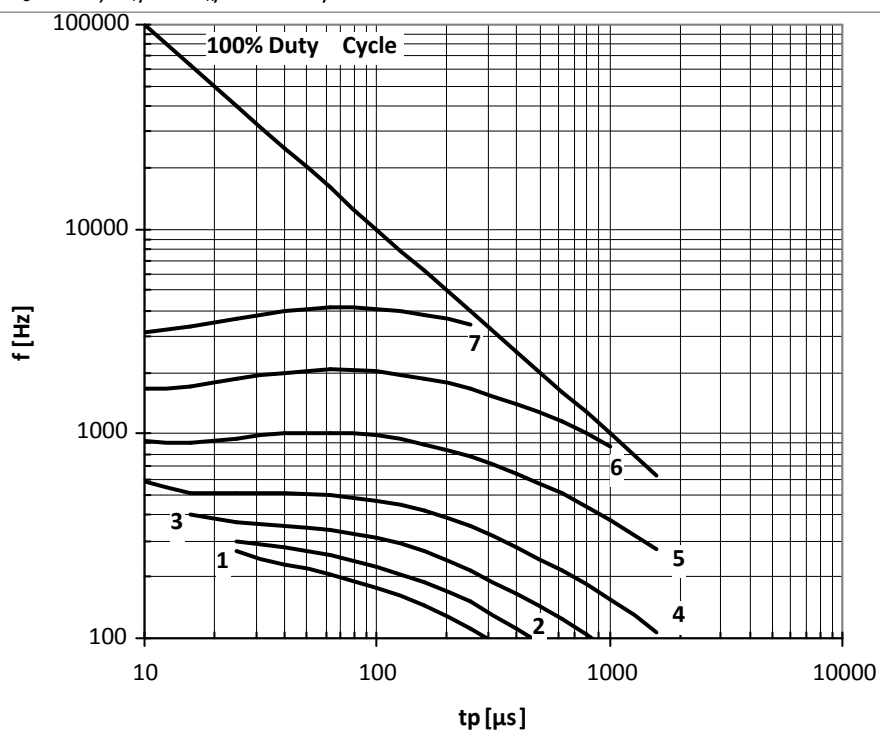


Рис. 21 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$; $T_C = 85$ °C; $di_F/dt = di_R/dt = 500$ A/мкс

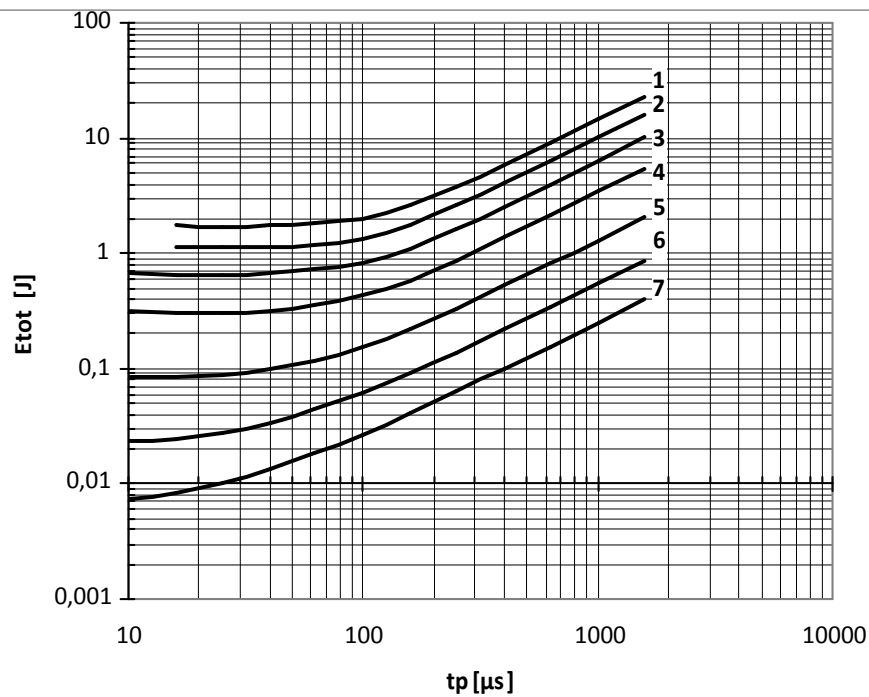


Рис. 22 – Зависимость энергии потерь за один синусоидальный импульс тока от длительности импульса

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R \approx 3$ В

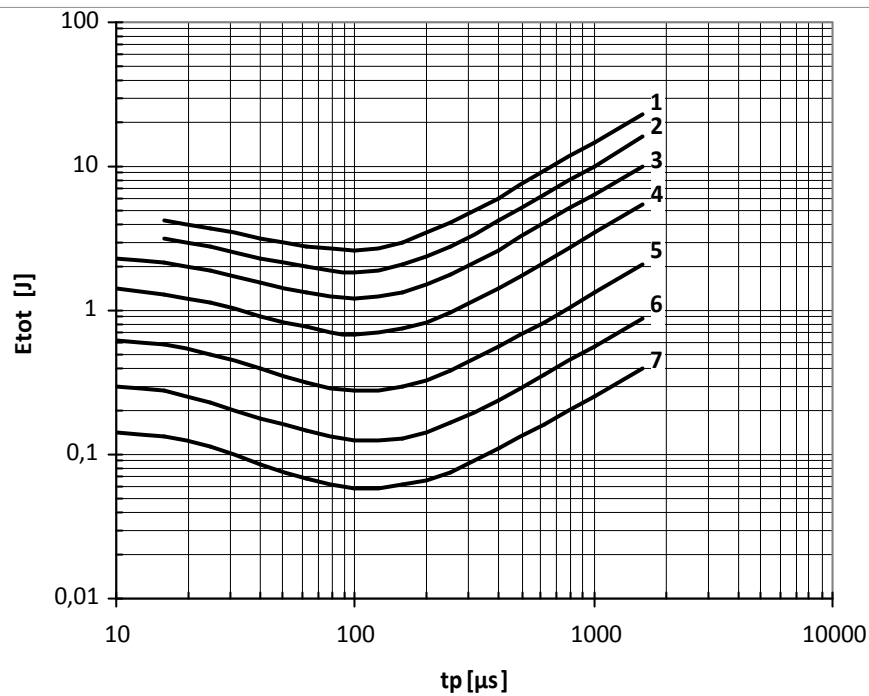


Рис. 23 – Зависимость энергии потерь за один синусоидальный импульс тока от длительности импульса

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$

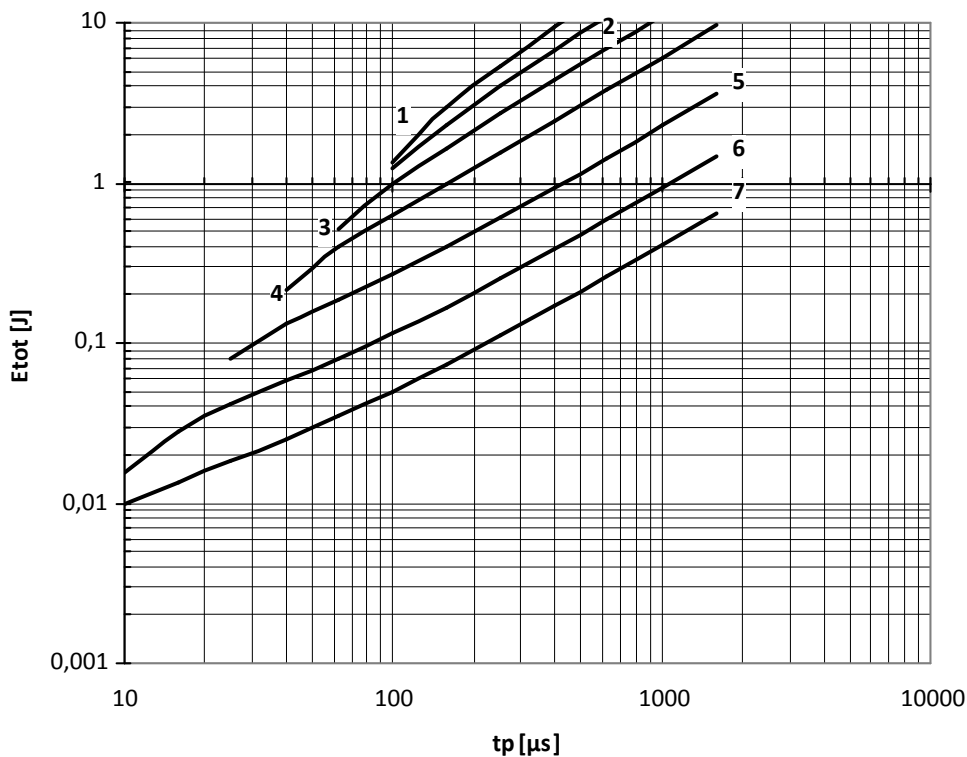


Рис. 24 – Зависимость энергии потерь за один синусоидальный импульс тока от длительности импульса

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R \leq 3$ В; $di_F/dt = di_R/dt = 100$ А/мкс

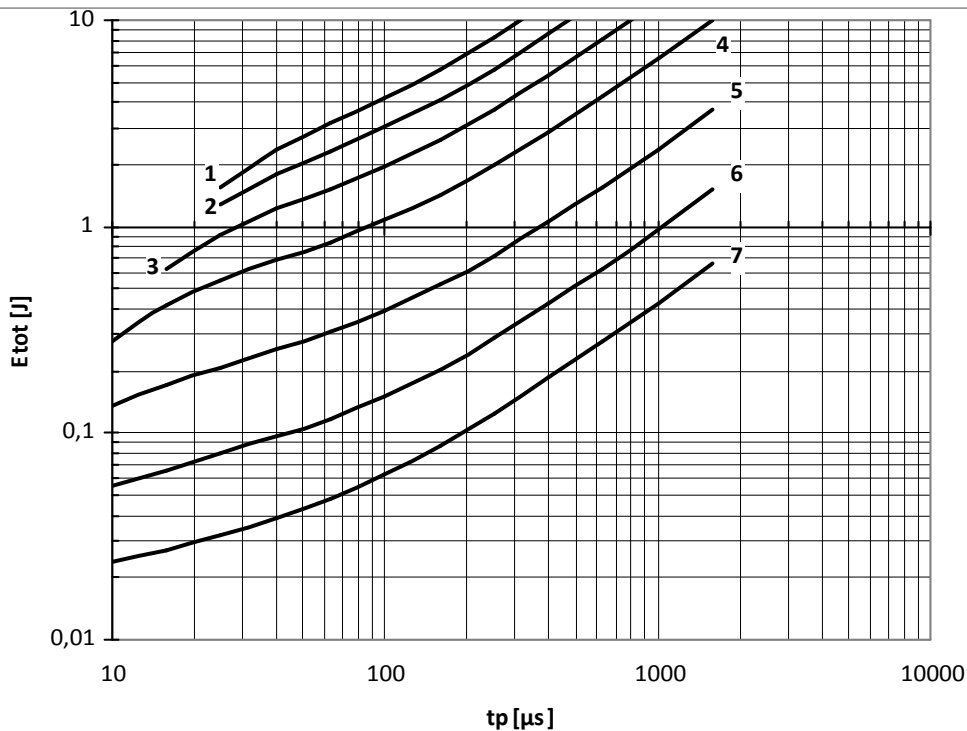


Рис. 25 – Зависимость энергии потерь за один синусоидальный импульс тока от длительности импульса

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R \leq 3$ В; $di_F/dt = di_R/dt = 500$ А/мкс

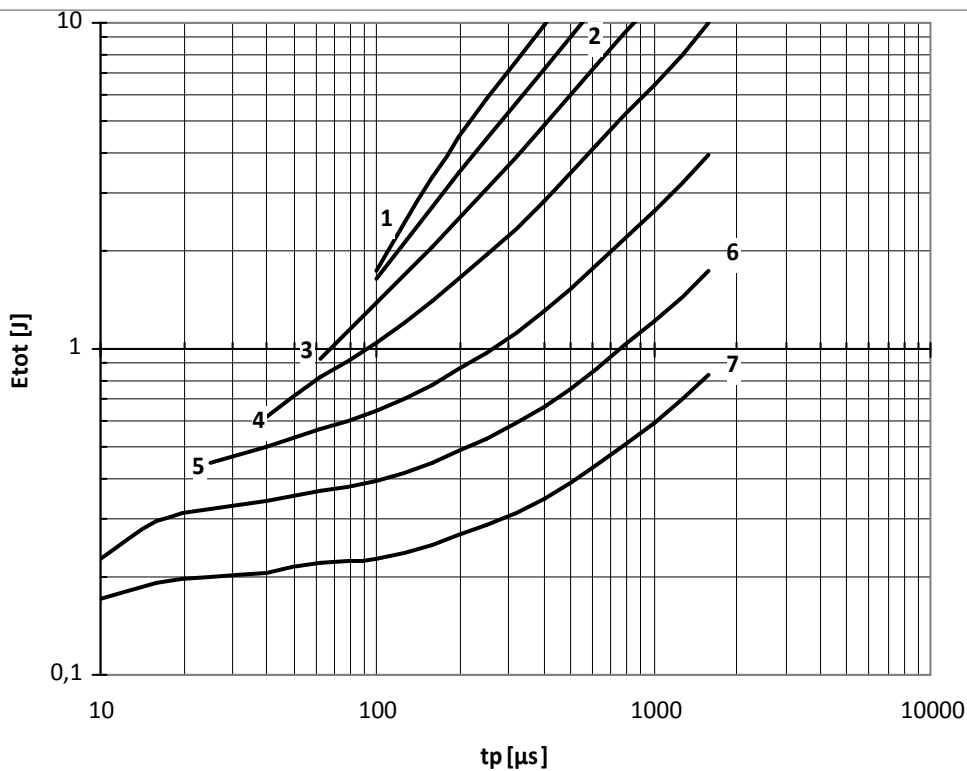


Рис. 26 – Зависимость энергии потерь за один синусоидальный импульс тока от длительности импульса

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$; $di_F/dt = di_R/dt = 100$ A/мкс

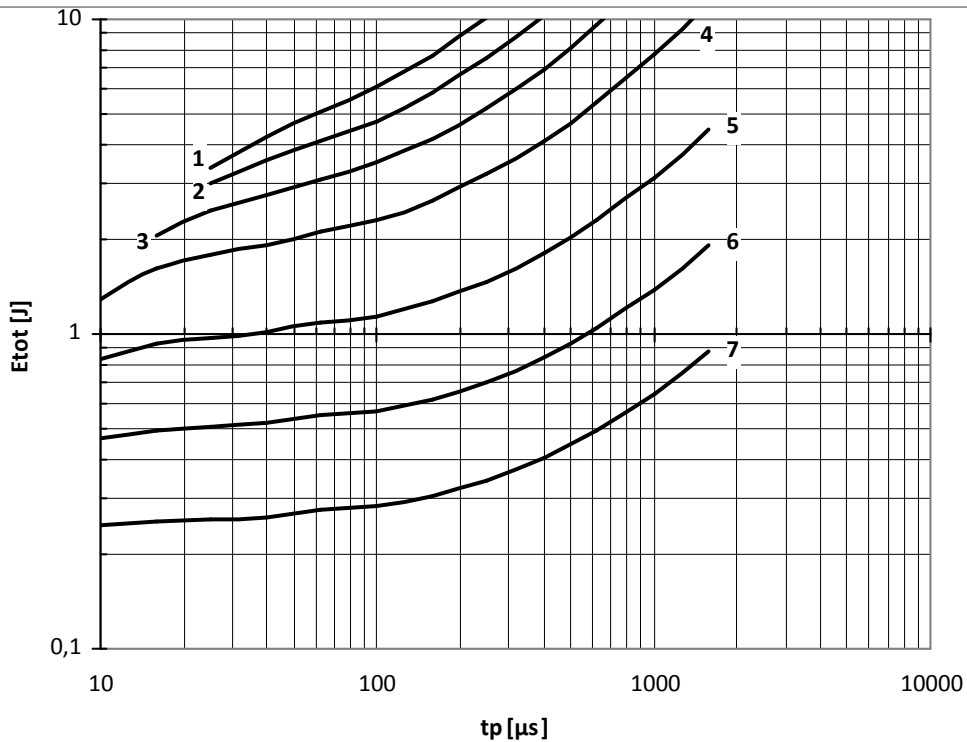


Рис. 27 – Зависимость энергии потерь за один синусоидальный импульс тока от длительности импульса

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$; $di_F/dt = di_R/dt = 500$ A/мкс

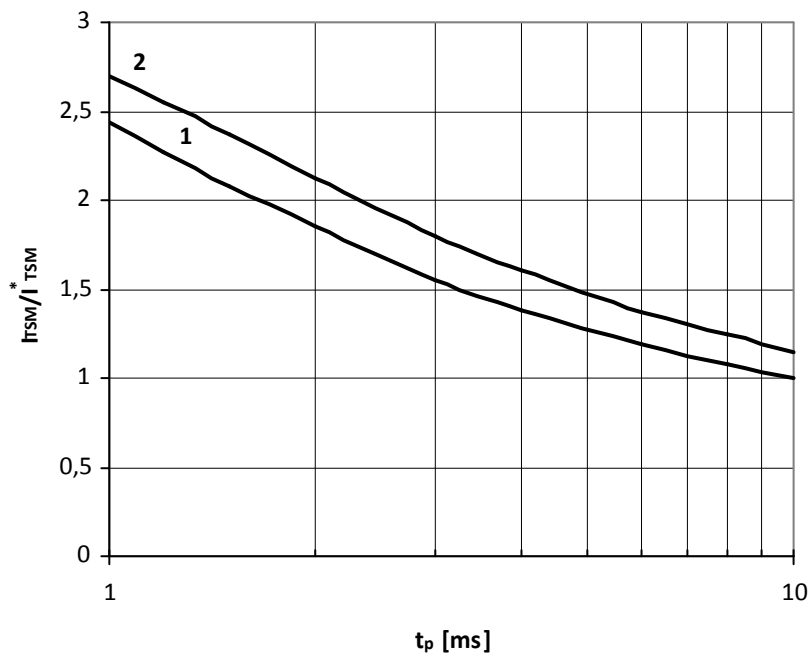


Рис. 28 – Зависимость ударного тока I_{TSM} от длительности импульса t_p для полусинусоидального импульса

1 – $T_j = 125^\circ\text{C}$

2 – $T_j = 25^\circ\text{C}$

Условия: $U_R = 0$ В – максимальное значение обратного напряжения, которое прикладывается сразу после ударного тока

Типичное изменение I_{TSM} относительно нормированного I_{TSM}^* (I_{TSM}^* – см. информационный лист, $T_j = T_{j\max}$)

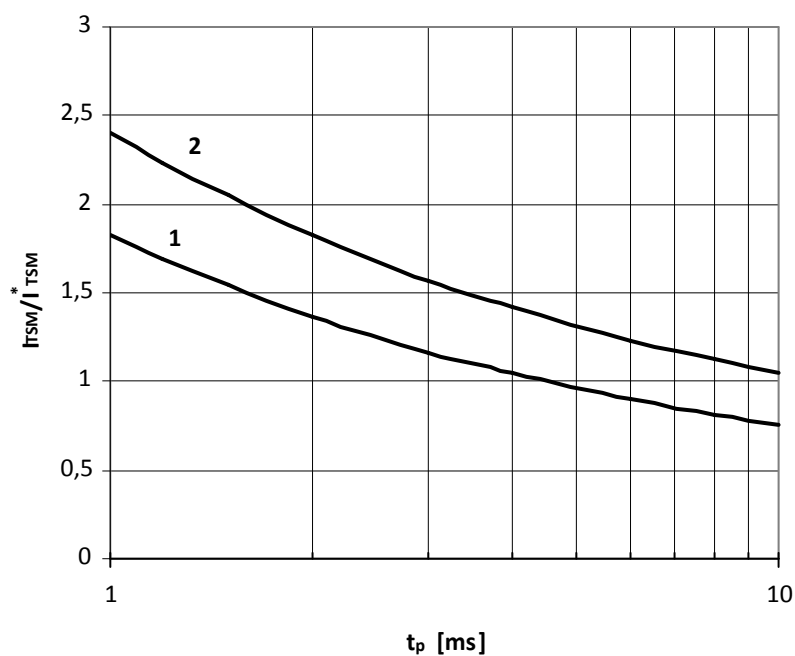


Рис. 29 – Зависимость ударного тока I_{TSM} от длительности импульса t_p для полусинусоидального импульса

1 – $T_j = 125^\circ\text{C}$

2 – $T_j = 25^\circ\text{C}$

Условия: $U_R = 0.8 U_{RRM}$ – максимальное значение обратного напряжения, которое прикладывается сразу после ударного тока

Типичное изменение I_{TSM} относительно нормированного I_{TSM}^* (I_{TSM}^* – см. информационный лист, $T_j = T_{j\max}$)

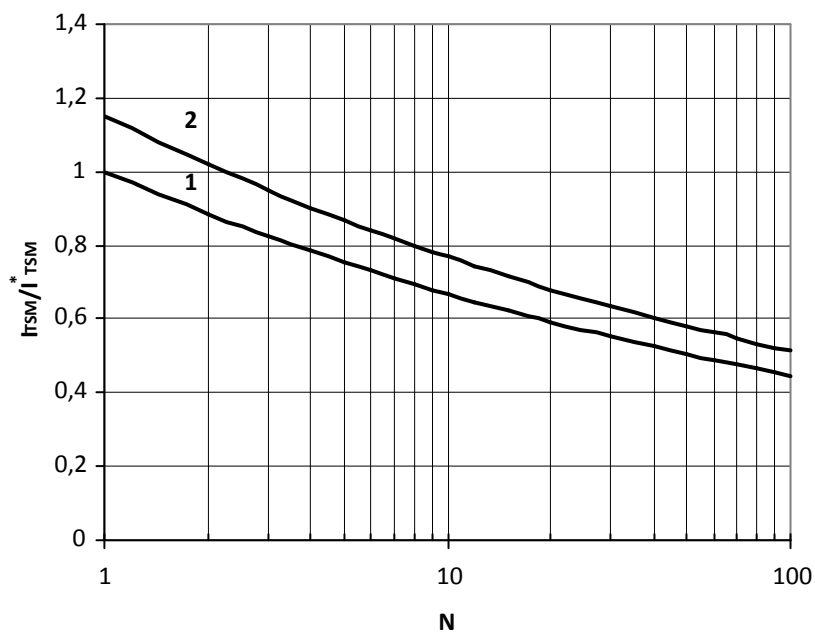


Рис. 30 – Ударный ток I_{TSM} от количества полусинусоидальных импульсов тока длительностью 10 мс
 1 – $T_j=125^\circ\text{C}$
 2 – $T_j=25^\circ\text{C}$

Условия: $U_R=0$ В – максимальное значение обратного напряжения, которое прикладывается сразу после ударного тока
 Типичное изменение I_{TSM} относительно нормированного I_{TSM}^* (I_{TSM}^* – см. информационный лист, $T_j=T_{j\max}$)

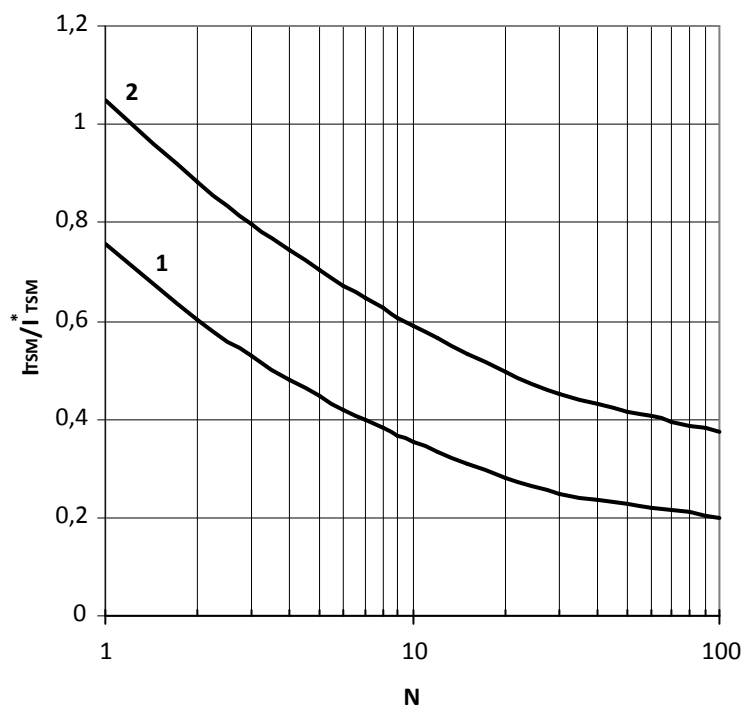


Рис. 31 – Ударный ток I_{TSM} от количества полусинусоидальных импульсов тока длительностью 10 мс
 1 – $T_j=125^\circ\text{C}$
 2 – $T_j=25^\circ\text{C}$

Условия: $U_R=0.8U_{RRM}$ – максимальное значение обратного напряжения, которое прикладывается сразу после ударного тока
 Типичное изменение I_{TSM} относительно нормированного I_{TSM}^* (I_{TSM}^* – см. информационный лист, $T_j=T_{j\max}$)